4C,8A/2009S2-008

SmVO₃の磁気軌道秩序に対する *R* サイトランダムネス効果 *R*-site randomness effect on spin/orbital ordering in SmVO₃

佐々木直哉^{1*},逸見和宏^{1*},福田龍一郎^{1*},宮坂茂樹^{1*},田島節子^{1*},山崎裕一^{2*},中尾朗子^{2*}, 中尾裕則^{2*},熊井玲児^{2*},村上洋一^{2*}, ¹阪大院理、〒560-0043 豊中市待兼山町 1-1 ²高エネ機構物構研 PF/CMRC、〒305-0801 つくば市大穂 1-1

1 <u>はじめに</u>

ペロブスカイト型 RVO₃(R:希土類または Y)は、R サイトのイオン半径を変化させることにより、G型 軌道・C型磁気秩序(以下 G-OO/C-SO)、または C型 軌道・G型磁気秩序(以下 C-OO/G-SO)という2種類 の磁気軌道秩序が現れる[1]。その中で、Rサイトイ オン半径のミスマッチによるランダムネスは、G-OO/C-SO を不安定化させ、C-OO/G-SO を安定化さ せる[2]。そこでその異常現象を調べるために、R サ イトのイオン半径を固定したランダムネスの導入を Sm_{1-x}(La_{0.322}Y_{0.678})_xVO₃により行った。イオン半径の 分散であるランダムネスの大きさはイオン半径の分 散で表され、これはxに比例して大きくなる。x = 0の SmVO₃においては、G-OO/C-SO しか現れない。 しかしながら、ランダムネスを大きくしていくと別 の秩序状態(C-OO/G-SO)が現れる。この新たに現れ る秩序状態を解明するために、粉末 X 回折による測 定と共鳴 X線散乱による測定を行った。

2 <u>実験</u>

試料は Floating Zone(FZ)法により単結晶化したものを使用した。格子定数の温度依存性を調べるために、BL-8Aにおいて粉末 X線回折測定を行った。粉末化した試料を $\phi=0.2$ または 0.3mmのリンデマンガラス製キャピラリに詰め、He 吹付式冷却装置を用いて冷却しながらエネルギー15keVの X線を用いて測定をした。

また、軌道秩序の存在確認と秩序パターンの決定 のために、共鳴 X 線散乱実験を行った。入射 X 線 は σ (散乱面に対して垂直)偏光であり、エネルギー は V の K 吸収端近くの 5.48keV を用いた。散乱 X 線の偏光依存性を見るためにパイログラファイトの (004)面を用いて π '(散乱面に対し平行)偏光と σ '(散 乱面に対し垂直)偏光に分解した。

3 結果および考察

Sm_{1-x}(La_{0.322}Y_{0.678})_xVO₃において、磁化の温度依存 性から決定した磁気軌道秩序相図を図1に示す。x = 0(variance; $\sigma^2 = 0$)においては、低温で *G*-OO/*C*-SO のみが出現し、*C*-OO/*G*-SO は出現しない。しかし、 x (variance)の増加とともに *G*-OO、*C*-SO の相転移温 度 T_{OO1} 、 T_{SO1} は減少傾向を示しx = 0.8において消失 している。一方で、x = 0では存在しなかった新しい 秩序相(*C*-OO/*G*-SO)がx = 0.5より出現し、xの増加 とともに相転移温度が上昇していく傾向が見られた。



図 1: Sm_{1-x}(La_{0.322}Y_{0.678})_xVO₃ における磁気軌道秩序 相図。緑丸[○]、青丸[●]、赤二重丸[◎]はそれぞれ *G*-OO、*C*-SO、*C*-OO/*G*-SO 相転移温度 *T*_{OO1}、*T*_{SO1}、 *T*_{SO2}を示す。

図 2 に BL-8A にて行った粉末 X 線回折から得ら れた格子定数の温度依存性と SQUID による磁化の 測定結果を示す。 $x = 0(SmVO_3)$ は相転移温度 T_{OO1} で、 G-OOの出現と同時に室温 orthorhombic Pbnm から低 温 monoclinic P2₁/b へ構造相転移を起こす。この構 造相転移に対応して格子定数に折れ曲がりが生じる。 さらに温度を下げると相転移温度 T_{so1} で C-SO が生 じ、磁化が大きく変化する。しかし、この点におい て構造は変化しないので格子定数に大きな変化はな い。x = 0.6 は低温側の磁化において新しい秩序が現 れた試料である。先ほどと同様に相転移温度 Tool、 T_{so1}において G-OO、C-SO に対応した格子定数、磁 化の振る舞いを示している。さらに低温部の相転移 温度 T_{SO2}においては、磁化、格子定数ともに先ほど と違う不連続な変化をしており新しい秩序相の存在 が示唆される。x = 1.0 は磁化の異常が1点しか見ら れなかった試料である。この試料においても相転移 温度 T_{SO2}において磁化、格子定数ともに不連続な変 化を生じており、x = 0.6の低温部で見られた新たな 秩序相と同じものであることが確認できる。また、 同様の実験が Eu1-x(La0 254 Y0 746)xVO3 においても行わ れており[3]、その類似性と次に示す共鳴 X 線散乱

の実験結果からこの相転移温度以下において *C*-OO/*G*-SOの出現が示唆される。



図 2: Sm_{1-x}(La_{0.322}Y_{0.678})_xVO₃ において、SQUID によ る磁化測定結果と粉末 X 線回折測定(BL-8A)によ る格子定数の温度依存性。(a) x = 0、(b) x = 0.6 (c) x = 1.0 の各組成の結果。

図 3 に共鳴 X 線散乱実験による測定結果を示す。 図 3(a) に Sm_{1-x}(La_{0.322}Y_{0.678})_xVO₃ x = 1.0 における (100)反射のエネルギースペクトルを示す。この (100)反射は通常禁制反射となり強度はゼロであるが、 C-OO が存在する場合は V の K 吸収端のみで強度が 有限となる。V の K 吸収端(~5.48keV)において、 最低温度 20K での(100)反射が有限値を取っている ことから C-OO の存在が示唆される。また、その温 度変化をみると相転移温度 T_{SO2} をまたいで強度が大 きく変化しているので、この相転移で C-OO が出現 していると言える。

また図 3(b)に Sm_{1-x}(La_{0.322}Y_{0.678})_xVO₃ $x = 1.0 \mathcal{O}(100)$ 反射のアジマス角依存性を示した。軌道秩序パター ンを決定するために、入射 X 線のエネルギーを V のK吸収端に固定してアジマス角依存性を測定した。 試料の表面形状による強度変化を考慮するために、 許容反射である(200)反射強度で規格化を行った。入 射 X 線は σ 偏光であり、散乱 X 線の偏光を σ 'と π ' に分解して測定した。入射 X 線の電場ベクトル Ei が orthorhombic Pbnm における b 軸に平行な方向を アジマス角ゼロとした。測定は 20K で行っている。 σ'偏光の場合、(100)反射強度は非常に弱くほぼゼ ロである。一方でπ'偏光の場合、(100)反射強度は $E_i \| b$ で最大値を取り、 $E_i \| c$ でほぼゼロになる。C-ΟΟ を仮定したモデル計算の結果を黒実線(π'偏光)、 赤点線(σ'偏光)で示した。それぞれの偏光における アジマス角依存性は C-OO におけるモデル計算とよ

く一致している。この事から $Sm_{1-x}(La_{0.322}Y_{0.678})_xVO_3$ x = 1.0 の 20Kにおいては、x = 0において存在しな かった *C*-OO が存在していることが示された。



図 3: (a) Sm_{1-x}(La_{0.322}Y_{0.678})_xVO₃ x = 1.0 における(100) 反射のエネルギースペクトル。中塗り丸印[●]は 磁化により決定した相転移温度以下での測定結 果であり、白抜き四角[□]は相転移温度以上での 測定結果である。(b)Sm_{1-x}(La_{0.322}Y_{0.678})_xVO₃ x = 1.0 の K 吸収端における(100)反射強度のアジマス角 依存性。(100)反射強度は同じアジマス角におけ る(200)反射強度を用いて規格化されている。

4 まとめ

SmVO₃において、R サイトにランダムネスを導入 する事により元々安定していた *G*-OO/*C*-SO が不安 定化していくとともに、新たに *C*-OO/*G*-SO が出現 する。さらに、ランダムネスの導入とともに *C*-OO/*G*-SO は安定化するという事が示された。

参考文献

[1] S.Miyasaka *et al.*, Phys.Rev.B,**68**,R100406(2003)
[2] J.-Q.Yan *et al.*, Phys.Rev.Lett,**99**,197201(2007)
[3] R.Fukuta *et al.*, Phys.Rev.B,**84**,140409(2011)

*sasaki@tsurugi.phys.sci.osaka-u.ac.jp